

Сведения о ведущей организации
 по диссертации Маковецкой Алёны Александровны
 «Исследование динамики горячих электронов в полевых транзисторах на гетероструктурах с дононо-акцепторным легированием для разработки перспективных СВЧ усилителей мощности»
 по специальности 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах»
 на соискание ученой степени кандидата технических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИСВЧПЭ РАН
Почтовый индекс, адрес организации	117105, Москва, Нагорный проезд, 7, стр.5
Веб-сайт	http://isvch.ru/
Телефон	Тел.: (499) 123-44-64 Факс: (499) 123-44-64
Сведения о руководителе, на имя которого нужно оформить письмо	Директор ИСВЧПЭ РАН, д. т. н., профессор Гамкрелидзе С.А.
Сведения о лице, с которым была достигнута предварительная договоренность по отзыву	Зав. лабораторией исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах, к.т.н., Д.Л. Гнатюк
Адрес электронной почты	isvch@isvch.ru, iuhfseras2010@yandex.ru
Наименование структурного подразделения, составляющего отзыв	Лаборатория исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах
<p>Список основных публикаций работников структурного подразделения, составляющего отзыв, за последние пять лет по теме диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. К.А. Kagirina, Yu.V. Fedorov, D.V. Lavrukhin, S.A. Gamkrelidze, D.L. Gnatyuk, A.V. Zuev, O.A. Ruban, D.V. Gromov. Stability analysis of monolithic integrated circuit of microwave signal converter to the influence of special factors. Russian Microelectronics, V. 46, No 3, pp. 149-154 (2017). 2. S.V. Mikhailovich, R.R. Galiev, A.V. Zuev, A.Yu. Pavlov, D.S. Ponomarev, R.A. Khabibullin The influence of gate length on the electron injection of velocity in an AlGaN/AlN/GaN HEMT channel. Technical Physics Letters. vol. 43. No. 8. pp. 733-735. (2017). 3. Ю.В. Федоров, А.С. Бугаев, А.Ю. Павлов, Д.Л. Гнатюк, О.С. Матвеев, В.Ю. Павлов, Д.Н. Слаповский, К.Н. Томош, Е.Н. Енюшкина, Р.Р. Галиев, М.В. Майтама, А.В. Зуев, Д.В. Крапухин, С.А. Гамкрелидзе. Технология изготовления и разработка монолитных интегральных схем на основе нитрида галлия. НМСТ, том 19, №5, стр. 273-293 (2017). 4. Д.В. Крапухин, П.П. Мальцев. Малошумящий усилитель для диапазона 57-64 ГГц с заземляющими отверстиями через слой фотолака. Микроэлектроника, Т. 46, № 5, С. 370-379 (2017). 5. О.С. Матвеев. Интегрированные антенны для использования в системах на 	

- кристалле. Нано- и микросистемная техника, №9, стр.568-574 (2017).
6. Ю.В. Федоров, Д.Л. Гнатюк, А.С. Бугаев, О.С. Матвеев, Р.Р. Галиев, А.В. Зуев, А.Ю. Павлов, С.В.Михайлович. Разработка монолитных интегральных схем для Ka-, V- и W-диапазонов на основе нитрида галлия. Микроэлектроника, 45(2), 135 (2016).
 7. С.В. Михайлович, Ю.В. Фёдоров. Влияние толщины барьерного слоя наногетероструктур и ёмкости затвор-сток на сверхвысокочастотные и шумовые параметры полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов на AlGaN/GaN. Известия вузов. Радиофизика, 59(2), 1 (2016).
 8. Ю.В. Фёдоров, С.В. Михайлович. Перспективы замены арсенидных МИС на нитридные. НМСТ, 18(4), 217 (2016).
 9. Федоров Ю.В., Мальцев П.П., Гнатюк Д.Л., Матвеев О.С., Крапухин Д.В., Гамкрелидзе С.А. Создание СВЧ монолитных ИС 5-миллиметрового диапазона для применения в перспективных КС. Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2016 г. – № 2. – С. 73-78.

Директор ИСВЧПЭ РАН



С.А. Гамкрелидзе